

■電気的特性

Electrical Characteristics (Ta=25°C)

項目	略号	条件	min	typ	max	単位
ゲート・ソース間降伏電圧 Gate to Source Breakdown Voltage	BV_{GSO}	$I_G = 0.1mA$	-30			V
ゲート漏洩電流 Gate Leak Current	I_G	$V_{GS} = -30V$			100	μA
オフ時ドレイン漏洩電流 Drain Cut-off Current	I_D	$V_{DS} = 250V$			100	μA
ドレイン電流 Drain Current	I_D	$V_{GS} = 0V$			10	A
ゲート・ソース間オフ電圧 Gate to Source Cut-off Voltage	$V_{GS(off)}$	$V_{DS} = 200V$ $I_D = 1mA$			-25	V
ゲート・ドレイン間降伏電圧 Gate to Drain Breakdown Voltage	BV_{GDD}	$I_D = 0.1mA$	250			V
電圧増幅率 Insertion Gain	μ	$V_{GS} = -1 \sim -10V$ 平均 $I_D = 0.1A$	8		12	
ゲート・ソース間容量 Gate to Source Capacitance	C_{GS}	$V_{GS} = 10V$ $f_r = 500KHz$		4,000		pF
ゲート・ドレイン間容量 Gate to Drain Capacitance	C_{GD}	$V_{GS} = 10V$ $f_r = 500KHz$		800		pF
遮断周波数 Cut-off Frequency	f_T	$V = 20V$ $I_D = 2A$		50		MHz
ドレイン・ソース間オン抵抗 Drain to Source ON Resistance	r_{on}	$V_{GS} = 0V$ $I_D = 10A$			1.8	Ω
ドレイン・ソース間オフ抵抗 Drain to Source OFF Resistance	r_{off}	$V_{DS} = 200V$ $V_{GS} = -25V$	1			M Ω
ターンオン時間 Turn ON Time	t_{on}	$I_D = 1.5A$ $V_{DS} = 50V$		100		ns
ターンオフ時間 Turn OFF Time	t_{off}			100		ns
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	Junction-case		0.4		$^{\circ}C/W$